I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 3841/86 DES RATES

vom 8. Dezember 1986

zur zeitweiligen Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für einige industrielle Waren

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 28,

nach Kenntnisnahme von dem Verordnungsentwurf der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die in dieser Verordnung genannten Waren werden in der Gemeinschaft gegenwärtig nicht oder nur in unzureichender Menge hergestellt. Die Hersteller können somit den Bedarf der verarbeitenden Industrien der Gemeinschaft nicht decken.

Es liegt im Interesse der Gemeinschaft, die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs in bestimmten Fällen, in denen insbesondere eine Gemeinschaftsproduktion dieser Waren besteht, nur teilweise und in den anderen Fällen vollständig auszusetzen.

Da es schwierig ist, die kurzfristige Entwicklung der wirtschaftlichen Lage auf den betreffenden Gebieten genau zu beurteilen, sollten die Aussetzungen nur zeitweilig erfolgen, wobei ihre Gültigkeitsdauer entsprechend den Interessen der Gemeinschaftsproduktion festzusetzen ist —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs werden für die in den Tabellen im Anhang aufgeführten Waren bis zu der jeweils angegebenen Höhe ausgesetzt.

Diese Aussetzungen gelten

— vom 1. Januar 1987 bis zum 31. März 1987 für die in Tabelle I aufgeführten Waren;

— vom 1. Januar 1987 bis zum 30. Juni 1987 für die in Tabelle II aufgeführten Waren.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1987 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 8. Dezember 1986.

Im Namen des Rates

Der Präsident

N. LAWSON

ANHANG

TABELLE I

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 38.19 X	Zubereitung auf der Grundlage von Asphaltsulfonaten der Alkalimetalle, mit einer Dichte von nicht weniger als 1,2 und nicht mehr als 1,5 und einer Wasserlöslichkeit von 70 Gewichtshundertteilen oder mehr	0
ex 39.02 C VI b)	Platten aus einem Mischpolymerisat aus Maleinsäureanhydrid und Styrol, beidseitig versehen mit einer Folie aus dem genannten Mischpolymerisat, modifiziert mit einem Styrol-Butadien-Blockmischpolymerisat, auch pigmentiert	0
ex 39.02 C XI	Polyvinylalkoholfolien, die sich in Wasser bei einer Temperatur von 20 °C auflösen	0
ex 81.04 F I	Hafnium, roh, mit einem Reinheitsgrad von 95 Gewichtshundertteilen oder mehr und einem Gehalt an Zirkonium von nicht mehr als 4,5 Gewichtshundertteilen	0

TABELLE II

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 27.07 G II	Mineralöl mit einem Gehalt an aromatischen Bestandteilen von mehr als 60 Gewichtshundertteilen und an Schwefel von weniger als 0,8 Gewichtshundertteilen, von dem bei der Destillation bis 250 °C nicht mehr als 15 Raumhundertteile übergehen, zum Herstellen von Nadelkoks (a)	0
ex 27.13 B II	Synthetisches Paraffin mit einem Molekulargewicht von nicht weniger als 460 und nicht mehr als 1 560	0
ex 28.20 A	Aluminiumhydroxidoxid in Form des Pseudo-Böhmits	4
ex 28.47 F	Bariumtitanat mit einem Gehalt an Eisen von nicht mehr als 0,05 Gewichtshundertteilen	0
ex 28.52 B	Lanthanbromidoxid	0
ex 29.02 A I	Hexafluorpropen	0
ex 29.02 A III	Dibrommethan	3
ex 29.02 B	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachlorpentracyclo [12.2.-1.1.^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}] octadeca-7,15-dien, zur Verwendung bei der Herstellung von Polyäthylen oder synthetischem Kautschuk (a)	0
ex 29.03 C I	Äthansulfonylchlorid	3
ex 29.09 B	1,2-Epoxybutan	0
ex 29.09 B	1,2-Epoxy-4-(epoxyäthyl)cyclohexan	0
ex 29.09 B	2,3-Epoxypropan-1-ol (Glycidol)	0
ex 29.14 A XI	Trimethylorthoacetat	0
ex 29.14 B I	2,3-Epoxypropylmethacrylat	0
ex 29.14 D IV	Methyl-3-chlorbenzoat	0
ex 29.16 D	Methyl-5-(2,4-dichlorphenoxy)-2-nitrobenzoat	5
ex 29.25 B II c)	Barbitursäure	0
ex 29.26 A I	1,2-Benzisothiazol-3-on-1,1-dioxid(*o*-Benzoesäuresulfimid, Saccharin) und sein Natriumsalz	0
ex 29.31 B	3,3-Dimethyl-1-methylthiobutanonoxim	0
ex 29.35 Q	Zotepin (INN)	4
ex 29.35 Q	Ofloxacin (INN)	0
ex 29.35 Q	3'-Chlor-6'-cyclohexylaminospiro [isobenzofuran-1(3*H*), 9'-xanthen]-3-on	0
ex 29.35 Q	6'-(*N*-Äthyl-*p*-toluidin)-2'-(*N*-methylanilin)spiro [isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 29.35 Q	Carteolol-Hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.39 D II	Methylprednisolon (INN) und seine Salze und Ester	1
ex 29.44 C und ex 30.03 A II b)	Vancomycin (INN) und seine Salze und Ester	0
ex 32.07 B	Anorganische Farbmittelzubereitungen im Sinne der Vorschrift 3 zu Kapitel 32 in Hohlkugeln aus Polyurethan mit einem Durchmesser von weniger als 200 Mikrometer	0
ex 32.09 A II und ex 39.01 C V	Mit einem Gehalt von 48 Gewichtshundertteilen oder mehr in *N*, *N*-Dimethylacetamid gelöstes Polyurethan aus 2,2,'-(*tert*-Butylimino) diäthanol und 4,4'-Methylendicyclohexyldiisocyanat	0
ex 32.09 A II und ex 39.02 C XIV a)	Mit einem Anteil von 48 Gewichtshundertteilen oder mehr in *N*, *N*-Dimethylacetamid gelöstes Mischpolymerisat aus *p*-Kresol und Divinylbenzol	0
ex 34.02	Wässerige Lösung mit einem Gehalt an Dinatriumalkyl [oxydi (benzolsulfonat)] von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 50 Gewichtshundertteilen	0
ex 35.07	Aspergillus-Alkalin-Proteinase	0
ex 38.16	Unsteriles Blutserum, gewonnen aus dem Blut von Rinderföten oder nicht immunisierten neugeborenen Kälbern	0
ex 38.19 E	Monoalkylbenzol-Gemische aus der Alkylierung von Benzol mit Polyalkenen, mit einem mittleren Molekulargewicht von nicht weniger als 680 und nicht mehr als 820	0
ex 38.19 G	Katalysator in Form von Pulver, aus einer auf einem Träger aus Siliciumdioxid fixierten Mischung von Titan-, Magnesium- und Aluminiumverbindungen, mit — nicht weniger als 3 und nicht mehr als 6 Gewichtshundertteilen Titan, — nicht weniger als 2 und nicht mehr als 3 Gewichtshundertteilen Magnesium, — nicht weniger als 0,3 und nicht mehr als 0,5 Gewichtshundertteilen Aluminium, zur Verwendung beim Herstellen von Polyäthylen mit einer Dichte von nicht weniger als 0,935 (a)	0
ex 38.19 G	Katalysator, bestehend aus einer Mischung von Titan-, Magnesium- und Aluminiumverbindungen, mit — nicht weniger als 3 und nicht mehr als 6 Gewichtshundertteilen Titan, — nicht weniger als 1,5 und nicht mehr als 3 Gewichtshundertteilen Magnesium, — nicht weniger als 0,3 und nicht mehr als 0,5 Gewichtshundertteilen Aluminium, in Hexan suspendiert, zur Verwendung beim Herstellen von Polyäthylen mit einer Dichte von nicht weniger als 0,930 (a)	0
ex 38.19 G	Katalysatoren, aus einer Suspension von Dialkyldimethylammoniumacetat (Kettenlänge der Alkylreste 16 und 18 Kohlenstoffatome) in einem organischen Lösungsmittel bestehend, mit einem Gehalt an Dialkyldimethylammoniumacetat von mindestens 40 Gewichtshundertteilen	0
ex 38.19 G	Katalysator in Form von Körnern oder Ringen mit einem Durchmesser von nicht weniger als 3 und nicht mehr als 10 mm, auf Aluminiumoxid fixiert, mit einem Gehalt an Silber von nicht weniger als 8 und nicht mehr als 20 Gewichtshundertteilen	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 38.19 S	Dotierte Silicium-Scheiben in Czochralski-Technik hergestellt, mit einem Durchmesser von 70 mm oder mehr, nicht poliert, mit einem Anteil an Sauerstoffatomen von $5 \times 10^{17}/cm^3$ oder mehr	0
ex 38.19 X	Mit einem Gehalt von nicht weniger als 35 und nicht mehr als 40 Gewichtshundertteilen in Dichlormethan gelöstes Aldicarb (ISO)	0
ex 39.01 C III a)	Einseitig metallbedampfte, in der Masse gefärbte Polyesterfolien mit einer Dicke von nicht mehr als 25 Mikrometer	6
ex 39.01 C III a)	Polykondensationserzeugnis aus Terephthalsäure mit einer Mischung aus Cyclohex-1,4-ylendimethanol und Äthan-1,2-diol, in Form von Folien	0
ex 39.01 C III a)	Polyesterfolien mit einer Dicke von nicht mehr als 70 Mikrometer, einseitig beschichtet mit einer Substanz, die sich beim Erhitzen auf nicht mehr als 100 °C unter Einwirkung von Salicylsäure verfärbt	0
ex 39.01 C III a)	Polyesterfolien mit einer Dicke von nicht mehr als 10 Mikrometer, einseitig beschichtet mit Salicylsäure	0
ex 39.01 C III b)	Polykondensationserzeugnis aus Terephtalsäure mit einer Mischung aus Cyclohex-1,4-ylendimethanol und Äthan-1,2-diol, in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39	0
ex 39.01 C V	Blätter aus mikroporigem Polyurethan mit eingebetteten Polyamid-Fasern, mit einer Dicke von nicht weniger als 0,5 und nicht mehr als 1,5 mm, zum Herstellen von Ledernachahmungen (a)	6,9
ex 39.02 C I a)	Polyäthylen in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39, mit einer Dichte von nicht weniger als 0,958 bei 23 °C und einem Gehalt von nicht mehr als — 50 ppm Aluminium, — 2 ppm Calcium, — 2 ppm Chrom, — 2 ppm Eisen, — 2 ppm Nickel, — 2 ppm Titan, — 8 ppm Vanadium, zum Herstellen von chlorsulfoniertem Polyäthylen (a)	0
ex 39.02 C I a)	Polyäthylen mit einer Dichte von nicht weniger als 0,945 und nicht mehr als 0,985, in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39, zum Herstellen von Farbbändern für Schreibmaschinen und ähnlichen Farbbändern (a)	0
ex 39.02 C VI a)	A-B-A-Blockmischpolymerisat aus Polystyrol, Äthylen-Butylen-Mischpolymerisat und Polystyrol, mit einem Gehalt an Styrol von nicht mehr als 35 Gewichtshundertteilen, in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39	0
ex 39.02 C XI	Polyvinylbutyralfolien mit Farbkeilband	6
ex 39.02 C XIV a)	Bromiertes Polystyrol mit einem Gehalt an Brom von nicht weniger als 58 und nicht mehr als 71 Gewichtshundertteilen, in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Ionomeres Harz, bestehend aus einem Salz eines Äthylen-Methacrylsäure-Mischpolymerisats	0
ex 39.02 C XIV a)	Ionomeres Harz, bestehend aus einem Salz eines Äthylen-Isobutylacrylat-Methacrylsäure-Mischpolymerisats	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 39.02 C XIV a)	Mischpolymerisat aus Acrylsäure und Alkylmethacrylat mit geringen Mengen eines anderen Monomeren, zur Verwendung als Verdickungsmittel beim Herstellen von Druckpasten für den Textildruck (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Äthylen-Acrylsäure- oder Äthylen-Methacrylsäure-Mischpolymerisat in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39, mit einem Gehalt an Acrylsäure oder Methacrylsäure von nicht weniger als 16 und nicht mehr als 30 Gewichtshundertteilen	0
ex 39.02 C XIV a)	Polymerisationserzeugnis aus Acrylsäure und geringen Mengen eines mehrfach ungesättigten Monomeren, bestimmt zur Verwendung als Stabilisierungsmittel in Emulsionen oder Dispersionen mit einem pH-Wert von mehr als 13 (a)	6
ex 39.02 C XIV b)	Folien aus einer Mischung von Polyvinylidenfluorid und einem Acrylpolymer mit einer Dicke von nicht weniger als 40 und nicht mehr als 60 Mikrometer	0
ex 39.02 C XIV b)	Platten aus einem Äthylen-Chlortrifluoräthylen-Mischpolymerisat mit einer Dicke von nicht weniger als 1 und nicht mehr als 3 mm, auch auf einer Seite mit einem Glasfasergewebe versehen	0
ex 39.02 C XIV b)	Folien aus einem Mischpolymerisat aus Äthylen und Chlortrifluoräthylen mit einer Dicke von nicht weniger als 12 und nicht mehr als 400 Mikrometer	0
ex 39.02 C XIV b)	Folien aus einem Äthylen-Methylacrylat-Mischpolymerisat mit einer Dicke von nicht mehr als 0,05 mm, zum Herstellen von Einmal-Handschuhen für medizinische Zwecke (a)	6
ex 39.03 B V a) 2	Äthylhydroxyäthylzellulose, in Wasser nicht löslich	0
ex 39.03 B V a) 2	Hydroxypropylzellulose	0
ex 51.01 A	Texturiertes Polypropylengarn mit wasserabweisender Imprägnierung auf Siliconbasis	0
ex 51.02 A I	Monofile aus Polytetrafluoräthylen	0
ex 56.01 A	Acetalisierte Mehrkomponenten-Spinnfasern mit Matrixfibrillenstruktur, bestehend aus emulsionspolymerisiertem Polyvinylalkohol und Polyvinylchlorid	0
ex 59.03 B	Vliesstoffe aus Polyvinylalkohol, mit einer Dicke von nicht weniger als 200 und nicht mehr als 280 Mikrometer und einem Quadratmetergewicht von nicht weniger als 20 und nicht mehr als 50 g, als Meterware oder nur quadratisch oder rechteckig zugeschnitten, auch getränkt oder bestrichen	0
ex 59.17 A	Nadelfilze aus synthetischen Spinnstoffen mit einem Grundgewebe aus synthetischen Spinnstoffen, auf einer Seite mit einem Polytetrafluoräthylenfilm versehen, zum Herstellen von Filtermaterial (a)	0
ex 70.07	Plane, bleihaltige Flachglasscheiben, geschliffen und poliert, mit bearbeiteten Kanten, mit — einer Dicke von nicht weniger als 3,5 und nicht mehr als 5 mm, — einem Durchmesser von nicht weniger als 135 und nicht mehr als 140 mm, — einer Dichte von 2,88 oder mehr und — einer Lichtdurchlässigkeit von 87 % oder mehr bei Wellenlängen von nicht weniger als 450 und nicht mehr als 800 Nanometern, zum Einbau in Videoprojektoren (a)	0
ex 70.11	Bildschirme, ganz aus Glas, mit einer Diagonalen von nicht mehr als 61 cm, mit aufgeworfenem Rand, zum Herstellen von monochromen Kathodenstrahlröhren (a)	0
ex 70.11	Konen mit profiliertem Rand und einer Diagonalen von nicht mehr als 61 cm, zum Herstellen von monochromen Kathodenstrahlröhren (a)	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 81.04 D I b)	Elektrolytisch gewonnenes Chrom, in Form von Kathodenplättchen, Briketts oder Pellets, mit einem Gesamtgehalt an Sauerstoff von nicht mehr als 0,10 Gewichtshundertteilen, einem Gesamtgehalt an Aluminium von nicht mehr als 0,015 Gewichtshundertteilen und einem Gehalt an in siedender 5 n Salzsäure und in siedender, rauchender Perchlorsäure unlöslichen und als Aluminium berechneten Aluminiumverbindungen von nicht mehr als 0,001 Gewichtshundertteilen zur Herstellung von einer Legierung für den Bau von folgenden Teilen von Gasturbinen oder Strahltriebwerken (a): — feststehende oder bewegliche Schaufelräder, einschließlich ihrer Ringe, — Klappen, — Düsen	0
ex 84.18 C II b)	Teile von Apparaten zum katalytischen Umwandeln von Stickstoffoxiden in Stickstoff und Wasser, bestehend aus in Wabenstruktur geformten und gebrannten Einheiten aus einer Mischung von Vanadiumoxiden oder Vanadiumsulfaten und Titandioxid oder Bariumsulfat oder von Vanadiumoxid, Titandioxid und Wolframoxid, in einem Rahmengestell aus Metall	0
ex 84.18 C II b)	Teile von Apparaten zum katalytischen Umwandeln von Stickstoffoxiden in Stickstoff und Wasser, bestehend aus mit einer Mischung von Vanadium-, Titan- und Molybdänoxiden beschichteten perforierten Platten, in einem Rahmengestell aus Metall	0
ex 84.53 B	Optische Schriftleser zum Abtasten von Punktmatrixzeichen und zum Umwandeln der Leseimpulse in elektrische Signale, bestehend aus einem Lesekopf mit Photosensor, einem Verstärker, einer Linse und zwei Lampen, über Flachkabel verbunden mit einer gedruckten Schaltung mit den Abmessungen von nicht mehr als 200 × 220 mm, die mindestens einen Mikroprozessor, eine Bilderkennungsschaltung und einen Analog-Digital-Wandler enthält.	1
ex 84.55 C	Punktmatrix-Anzeigen mit den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 90 × 280 mm — ausgenommen Anschlußstücke und Leitungen —, bestehend aus einer zwischen zwei Glasplatten eingeschlossenen Flüssigkristallschicht mit 30 720 Punkten (angeordnet in 64 Zeilen und 480 Kolonnen), auf einer Leiterplatte mit elektronischen Bauelementen zur Steuerung und Kontrolle, auch mit Leitungen und Anschlußstücken	0
ex 84.55 C	Punktmatrix-Anzeigen mit den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 75 × 186 mm, bestehend aus einer zwischen zwei Glasplatten eingeschlossenen Flüssigkristallschicht mit 15 360 Punkten (angeordnet in 64 Zeilen und 240 Kolonnen), auf einer Leiterplatte mit elektronischen Bauelementen in C-MOS-Technik, und mit nicht mehr als 544 Kontaktflächen	0
ex 84.55 C	Magnetköpfe in Winchester- oder Dünnfilmtechnik für periphere Magnetplatten-Speichereinheiten, mit einer Aufzeichnungsdichte von nicht weniger als 10 Spuren je mm, auch auf Trägerarmen	0
ex 84.55 C	Baugruppe für automatische Datenverarbeitungsmaschinen, die einen programmierbaren UV-löschbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 256 Kbit bildet und aus einem mehrlagigen Substrat mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm besteht, auf dem angebracht sind: — zwei programmierbare UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMs), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen, mit einer Speicherkapazität von jeweils 128 Kbit und je einem Quarzfenster auf der Oberseite, — ein Decoder in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, — ein Entkopplungskondensator, — zwei Widerstände. Die Baugruppe trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält EDH 7832 MM-30 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher-Baugruppen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	2

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 84.55 C	Baugruppe für automatische Datenverarbeitungsmaschinen, die einen programmierbaren UV-löschbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 256 Kbit bildet und aus einem mehrlagigen Substrat mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm besteht, auf dem angebracht sind: — vier programmierbare UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMs), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen mit einer Speicherkapazität von jeweils 64 Kbit und je einem Quarzfenster auf der Oberseite, — ein Decoder in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, — ein Entkopplungskondensator. Die Baugruppe trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: EDH 7832 MC-35 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher-Baugruppen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	2
ex 84.55 C	Baugruppe für automatische Datenverarbeitungsmaschinen, die einen statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik (sogenannter C-MOS-RAM, statisch) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 32 Kbit bildet und aus einem mehrlagigen Substrat mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm besteht, auf dem angebracht sind: — zwei statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen, mit einer Speicherkapazität von jeweils 16 Kbit, — ein Decoder in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, — ein Entkoppelungskondensator. Die Baugruppe hat nicht mehr als 28 Anschlußstifte und trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: EDH-8804 C-20 EDH 8804 CL-20 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher-Baugruppen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	2
ex 84.55 C	Baugruppe für automatische Datenverarbeitungsmaschinen, die einen statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik (sogenannter C-MOS-RAM, statisch) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 64 Kbit bildet und aus einem mehrlagigen Substrat mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm besteht, auf dem angebracht sind: — vier statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen mit einer Speicherkapazität von jeweils 16 Kbit, — ein Decoder in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, — ein Entkopplungskondensator. Die Baugruppe hat nicht mehr als 28 Anschlußstifte und trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher-Baugruppen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	2

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 84.55 C	Baugruppe für automatische Datenverarbeitungsmaschinen, die einen programmierbaren UV-löschbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit und einen statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik (sogenannter C-MOS-RAMs, statisch) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 32 Kbit bildet und aus einem mehrlagigen Substrat mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm besteht, auf dem angebracht sind: — ein programmierbarer UV-löschbarer Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit und einem Quarzfenster auf der Oberseite, — zwei statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen mit einer Speicherkapazität von jeweils 16 Kbit, — ein Decoder in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, — ein Entkopplungskondensator, — zwei Widerstände. Die Baugruppe hat nicht mehr als 28 Anschlußstifte und trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: EDH 90804 BS-25 (15) EDH 90804 BS-30 (20) oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Baugruppen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	2
ex 84.55 C	Baugruppe für automatische Datenverarbeitungsmaschinen, bestehend aus 2 übereinander angeordneten Substratebenen mit 1 oder 2 statischen Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff in bipolarer Technik hergestellt (sogenannte bipolare RAMs, statisch), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen, mit einer Speicherkapazität von jeweils 1 Kbit und einer Gesamtspeicherkapazität von nicht mehr als 4 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 23 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 13 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 770965 4599497 7379442 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher-Baugruppen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 84.55 C	Baugruppe für automatische Datenverarbeitungsmaschinen, die einen 32-bit-Mikroprozessor in C-MOS-Technik bildet und aus zwei getrennten Chips auf einem Substrat mit den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 55 mm besteht, auf dem angebracht sind: — eine Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit/CPU), — eine Speichereinheit. Die Baugruppe hat nicht mehr als 60 Anschlußstifte und trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 57-00000 57-19400 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Baugruppen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 84.55 C	Magnetblasenspeicher mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 4 Megabit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 42 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 43 × 44 mm.	

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 84.55 C *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA BDL 0134 MBM 2256 7110 BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Magnetblasenspeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 84.55 C	Arithmetisches logisches Element für die Zentraleinheit, bestehend aus nicht mehr als neun gedruckten Schaltungen mit den Abmessungen von nicht mehr als 290 × 310 mm, jeweils bestückt mit nicht mehr als 121 ECL-Gate Arrays oder ECL-Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte ECL-RAMs) oder einer Kombination von beiden, die sich in einem Gestell mit den Abmessungen von nicht mehr als 501 × 596 × 611 mm befinden, das als Halterung und Verbindungsleiter für die gedruckten Schaltungen dient. Das Element trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf arithmetische logische Elemente der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 84.55 C	Punktmatrix-Anzeigen mit den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 115 × 290 mm – ausgenommen Anschlußstücke und Leitungen – bestehend aus einer zwischen zwei Glasplatten eingeschlossenen Flüssigkristallschicht mit 128 000 Punkten (angeordnet in 200 Zeilen und 640 Kolonnen), auf einer Leiterplatte mit elektronischen Bauelementen zur Steuerung und Kontrolle, auch mit Leitungen und Anschlußstücken	0
ex 84.55 C	Speichereinheit für elektronische Schreibmaschinen, bestehend aus einer gedruckten Schaltung mit 2 oder 4 statischen Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte RAMs, statisch) mit einer Speicherkapazität von jeweils 8 K × 8 bit, elektronischen Bauelementen zur Steuerung und Kontrolle und Haltestrombatterien, in einer Kassette mit Steckverbindungen und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 40 × 90 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MEMOCART oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Speichereinheiten der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 84.59 B	In einem Stück geschmiedete und vorgedrehte Teile von Reaktordruckbehältern mit einem Stückgewicht von jeweils mehr als 150 t	0
ex 84.61 B	Hydraulisches Fünfstufenventil, bestehend im wesentlichen aus drei Kunststoffteilen und zwei Magnetventilen zur Servosteuerung, zum Einbau in Wasserenthärtungsanlagen mit automatischer Regeneration (Strom und Gegenstsrom) und einer Ionenaustauschkapazität von nicht mehr als 650 l (a)	0
ex 84.63 B II	In einem Stück geschmiedete und vorgedrehte Generator- und Turbinenwellen mit einem Stückgewicht von jeweils mehr als 215 Tonnen	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.01 B I b)	Bürstenlose Gleichstrommotoren mit einem Drehmoment von nicht mehr als 0,20 Newtonmeter/Nm, eingebauter elektronischer Steuerungsplatte, Außenrotor mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von nicht mehr als 95 mm, Aluminium-Präzisionsnabe mit einem Innendurchmesser von 28,6 mm, einer Geschwindigkeit von 300 oder 360 Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 12 V ± 10 %	0
ex 85.01 B I b)	Bürstenlose Gleichstrommotoren mit einem Drehmoment von nicht mehr als 0,20 Newtonmeter/Nm, einem Außenläufer mit einem Durchmesser von nicht mehr als 55 mm, einem Befestigungsflansch von 77 mm und einer Präzisionsspindel mit einem Durchmesser von 44 mm mit 4-Phasen-Wicklung, mit einer Nenndrehzahl von 3 600 Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 12 V ± 10 %, mit Drähten und Anschlußstücken	0
ex 85.01 B I b)	Bürstenlose Zwei- oder Dreiphasen-Gleichstrommotoren mit einem Drehmoment von nicht mehr als 0,20 Newtonmeter/Nm, elektronischer Steuerungsplatte und den Abmessungen von nicht mehr als 85 × 85 mm und einer Dicke von nicht mehr als 20 mm einschließlich Spindel, Außenrotor mit einem Durchmesser von nicht mehr als 62 mm, einer Geschwindigkeit von 300 Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 12 V ± 10 %	0
ex 85.01 B I b)	Bipolare Schrittmotoren mit einem Schrittwinkel von 1,8 Grad, 200 Schritten pro Umdrehung, 2-Phasen-Drehfolge mit bipolarer Wicklung, mit den Abmessungen von nicht mehr als 20 × 39 × 39 mm oder 25 × 39 × 39 mm, gemessen ohne Welle, Feststellschrauben und Nabe, mit einem Drehmoment von 0,25 Newtonmeter/Nm oder mehr bei Motoren mit einer Höhe von nicht mehr als 20 mm oder von 0,35 Newtonmeter/Nm oder mehr bei Motoren mit einer Höhe von nicht mehr als 25 mm	0
ex 85.01 B I b)	Hybrid-Schrittmotoren mit einem Schrittwinkel von 0,9 Grad, 400 Schritten pro Umdrehung, 4-Phasen-Drehfolge mit bipolarer Wicklung, bestehend aus einem Rotor und einem Ständerpaket, das zwischen zwei Viereckflanschen mit den Seitenlängen von nicht mehr als 40 mm eingeschlossen ist, mit durchgehender Welle, Drähten und Anschlußstücken	0
ex 85.01 B I b)	Hybrid-Schrittmotoren mit einem Schrittwinkel von 0,9 Grad, 400 Schritten pro Umdrehung, 2-Phasen-Drehfolge mit bipolarer Wicklung, bestehend aus einem Rotor und einem Ständerpaket, das in einem zylindrischen Behälter mit einem Durchmesser von nicht mehr als 47 mm und einer Dicke von nicht mehr als 14 mm eingeschlossen ist, mit durchgehender Welle, Drähten und Anschlußstücken	0
ex 85.01 B I b)	Hybrid-Schrittmotoren mit einem Schrittwinkel von 0,9 Grad, 400 Schritten pro Umdrehung, 2-Phasen-Drehfolge mit bipolarer Wicklung, bestehend aus einem Rotor und einem Ständerpaket, das zwischen zwei Viereckflanschen mit den Seitenlängen von nicht mehr als 40 mm eingeschlossen ist, mit eingebautem 2- oder 3-Phasen-Drehzahlmesser in einer Kalotte mit einem Durchmesser von nicht mehr als 35 mm, mit gesonderten Drähten und Anschlußstücken für die Ausgänge des Motors und des Drehzahlmessers, mit den Abmessungen von nicht mehr als 40 × 40 × 62 mm, einschließlich Welle	0
ex 85.01 B I b)	Bipolare Gleichstrom-Schrittmotoren mit einteiligem Stator, einer Leistung von 37,5 W oder weniger, einem Schrittwinkel von 180 Grad, 2 Schritten pro Umdrehung, 2-Phasen-Drehfolge mit unipolarer Wicklung, einem Drehmoment von nicht weniger als $0{,}1 \times 10^{-6}$ Newtonmeter/Nm und nicht mehr als $0{,}1 \times 10^{-4}$ Nm und einer Versorgungsspannung von nicht mehr als 3 V	0
ex 85.01 B I b)	Hybrid-Schrittmotor mit einem Schrittwinkel von 0,9 Grad, 400 Schritten pro Umdrehung, 2-Phasen-Drehfolge mit bipolarer Wicklung, bestehend aus einem Rotor und einem Ständerpaket, das zwischen zwei Flanschen eingeschlossen ist, von denen der eine einen Viereckquerschnitt mit den Seitenlängen von nicht mehr als 40 mm hat und der andere (vordere) scheibenförmig ist und zwei Auskragungen aufweist, mit eingebautem 2- oder 3-Phasen-Drehzahlmesser in einer Kalotte mit einem Durchmesser von nicht mehr als 35 mm, mit gesonderten Drähten und Anschlußstücken für die Ausgänge des Motors und Drehzahlmessers, mit den Abmessungen von nicht mehr als 40 × 40 × 62 mm einschließlich der Welle, aber ohne die Auskragungen des vorderen Flansches	0
ex 85.01 B II	Stromrichter, bestehend aus einer Kaskadenschaltung von 7 Dioden, für Ausgangsspannungen von 40 kV oder mehr mit einer Stromstärke von 3 mA oder mehr	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.03	Kohle-/Zink-Trockenbatterien mit einer Spannung von nicht weniger als 5,5 und nicht mehr als 6,5 Volt und einer Größe von nicht mehr als 5 × 90 × 110 mm, zur Verwendung in Filmkassetten für Sofortbildkameras (a)	0
ex 85.03	Lithium-Jod-Batterien mit den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 23 × 45 mm und einer Spannung von nicht mehr als 2,8 V	0
ex 85.13 B und ex 85.21 D II	Optoelektronisches Empfangsmodul (PIN-FET-Empfänger) mit einem Wellenlängenbereich von nicht weniger als 1 300 und nicht mehr als 1 600 Nanometern und einer Geschwindigkeit von 678 Megabits/Sekunde oder mehr, in Form einer integrierten hybriden Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 13 × 25 mm und ausgerüstet mit einem Lichtwellenumkehrleiter aus optischen Fasern (Pigtail-Ankopplung). Das Modul trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen-/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 416/7/97013 QDFI-XXXX-001 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Empfangsmodule der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.18 B	Einstellbare Kondensatoren in runder Form mit einem Durchmesser von nicht mehr als 3 mm und einer Dicke von nicht mehr als 3 mm, ausgerüstet mit einer Stellschraube in der Mitte und zwei Anschlüssen, mit einer Kapazität von nicht weniger als 5 und nicht mehr als 30 Picofarad, zum Herstellen von Waren des Kapitels 91 (a)	0
ex 85.19 A	Thermorelais in hermetisch versiegeltem Glasgehäuse, mit den Längenabmessungen – ohne Drähte – von nicht mehr als 35 mm, mit einer maximalen Undichtigkeit von 10^{-6} cm^3 Helium/Sekunde bei 1 bar innerhalb des Temperaturbereichs von 0 bis 160 °C, zum Einbau in Kompressoren für Kältemaschinen (a)	0
ex 85.19 A	Reedschalter in Form eines Glasgehäuses, mit nicht mehr als drei elektrischen Kontakten auf Metallzungen und einer kleinen Menge Quecksilber	0
ex 85.19 C	Gedruckte Schaltung, einseitig bedruckt, mit den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm, zum Herstellen von Waren des Kapitels 91 (a)	0
ex 85.21 A V	Lochmasken-Farbkathodenstrahlröhren (Elektronenkanonen in Dreiecksanordnung – sogenannte Delta-Technik –), mit einem Abstand zwischen den Farbpunkten von nicht mehr als 0,31 mm und einer Vorrichtung zur Konvergenzautomatik	0
ex 85.21 A V	Kathodenstrahlspeicherröhren (sogenannte Direktsicht-Speicherröhren/Direct View Storage Tubes) für die Wiedergabe alphanumerischer und analoger Daten, mit Abtastvorrichtung zum Lesen der gebildeten Zeichen	0
ex 85.21 A V	Lochmasken-Farbkathodenstrahlröhren (Elektronenkanonen in Reihenanordnung – sogenannte In-Line-Technik –), mit einem Abstand zwischen den Farbpunkten von weniger als 0,45 mm und einem oder mehreren der nachstehenden Beschaffenheitsmerkmale: — einer Diagonalen des Bildschirms von weniger als 26 cm oder von 42 cm oder mehr, einer diagonalen Ablenkung von nicht mehr als 90 ° und Konvergenzfehlern in den Ecken von nicht mehr als 0,8 mm, — einem integrierten Anti-Vibrationssystem (sogenanntes Potting-System), — ohne internen Magnetschirm, — einer Phosphorbeschichtung mit folgenden nominalen Koordinaten der Farbpunkte: *rot* *grün* *blau* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06	

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
85.21 A V *(Fortsetzung)*	oder X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 oder X 0,62 0,21 0,15 Y 0,33 0,615 0,06 oder X 0,61 0,307 0,15 Y 0,35 0,595 0,065 oder X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,68 0,065 oder X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,6 0,065	0
ex 85.21 A V	Lochmasken-Farbkathodenstrahlröhren (Elektronenkanonen in Dreiecksanordnung – sogenannte Deltatechnik –), mit einem Abstand zwischen den Farbpunkten von weniger als 0,4 mm und einem der nachstehenden Beschaffenheitsmerkmale: — einer Diagonalen des Bildschirms von 66 cm oder mehr oder — einer Phosphorbeschichtung mit folgenden nominalen Koordinaten der Farbpunkte: *rot* *grün* *blau* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06 oder X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 oder X 0,61 0,307 0,15 Y 0,35 0,595 0,065 oder X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,68 0,065 oder X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,60 0,065	0
ex 85.21 A V	Anzeigen in Form einer Röhre, bestehend aus einem Glasgehäuse, aufgebracht auf einer Platte mit einer Größe – ohne Berücksichtigung der Leitungen – von nicht mehr als 5300 x 350 mm. Die Röhre enthält eine oder mehrere Reihen von Zeichen oder Strichen. Jedes Zeichen oder jeder Strich enthält fluoreszierende oder phosphoreszierende Elemente, die auf einer von fluoreszierenden Substanzen oder von Phosphorsalzen überzogenen metallisierten Unterlage aufgebracht sind und leuchten, wenn sie von Elektronen getroffen werden	0
ex 85.21 A V	Monochrome Kathodenstrahlröhren mit flachem Bildschirm, mit einer Diagonalen von nicht weniger als 142 und nicht mehr als 145 mm, einer Leuchtkraft zwischen 300 und 400 Lumen, einem Auflösungsvermögen von nicht weniger als 0,06 und nicht mehr als 0,1 mm, einer Phosphorbeschichtung des Typs P1 oder P55 oder P56, einer Anodenspannung von 34 kV oder mehr, einer Fokussierspannung von 7 kV oder mehr und einem Kathodenstrom von 3 mA oder mehr	0
ex 85.21 C	Piezoelektrische Quarzkristalle mit einer Frequenz von 32 768 Hz, in einem zylindrischen Gehäuse mit einer Länge von nicht mehr als 8,2 mm und einem Durchmesser von nicht mehr als 3,2 mm, zum Herstellen von Waren des Kapitels 91 (a)	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II	Digitalanzeigen, in einem Kunststoffgehäuse mit einer Größe von nicht mehr als 25 x 35 mm, bestehend aus einer Leiterplatte, die nicht mehr als 22 Leuchtdioden enthält, die von Halbleiterteilen aus im wesentlichen Gallium hergestellt sind. Jede Anzeige besteht aus einer einzigen Stelle, auch mit Plus- oder Minuszeichen und/oder mit nicht mehr als 2 Dezimalpunkten	7
ex 85.21 D II	Digitalanzeigen, bestehend aus einer Leiterplatte mit einer Größe von nicht mehr als 35 x 90 mm und einer Reihe von nicht weniger als 3 Anzeigestellen, die Leuchtdioden enthalten, die von Halbleiterteilen aus im wesentlichen Gallium hergestellt sind; letztere sind in die Leiterplatte eingebaut. Jede Anzeigestelle besteht aus nicht mehr als acht Segmenten, auch mit einem Dezimalpunkt. Die Digitalreihe hat einen Schutzbelag aus Kunststoff	0
ex 85.21 D II	Germanium-Golddraht-Dioden mit einer Durchlaßspannung von 1 V oder weniger bei 5 mA	0
ex 85.21 D II	Leuchtdioden, die von Halbleiterteilen aus im wesentlichen Gallium hergestellt sind, in einem Gehäuse mit 2 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 20 x 21 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: LT 9305 SLF 209 LT 9306 SLF 909 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Leuchtdioden der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Lesespeicher (sogenannter ROM), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 16 K x 8 bit, mit Leseregister und Kontrolle für seriellen Output in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 x 50 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 62000 bis 62999 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Lesespeicher in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-ROM), mit einem Versorgungsstrom im Bereitschaftszustand von nicht mehr als 0,03 mA, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 54 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 x 50 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: HN 61256 HN 613256 MB 83256 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 85.21 D II	Lesespeicher in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-ROM), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 1 Megabit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 x 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:	

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II *(Fortsetzung)*	HN 62301 P, MB 83 1000, MB 831124, TC 53 1000 P oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 85.21 D II	Programmierbare Lesespeicher, nicht löschbar (sogenannte PROMs), in TTL-Schottky-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 27 S 12 5305 6305 76 LS 03 27 S 13 5306 6306 7620 5308 6308 7621 28 L 22 5309 6309 28 LA 22 53 S 240 63 S 240 82 S 114 28 L 2 XMFC 53 S 241 63 S 241 82 S 130 6335 82 S 131 29613 54 S 570 6336 29770 54 S 571 93436 29771 7053 93446 5604 7058 38510 5624 MB 7115 74 S 570 MB 7116 74 S 571 MB 7117 MB 7118 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Programmierbare Lesespeicher, nicht löschbar (sogenannte PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 4 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften oder nicht mehr als 28 Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 18 S 42 29620 54 S 472 74 S 472 18 S 46 29621 54 S 473 74 S 473 18 SA 42 29622 54 S 474 74 S 474 18 SA 46 29623 54 S 475 74 S 475 29624 54 S 476 74 S 476 24 S 41 29625 54 S 477 74 S 477 24 SA 41 29626 54 S 572 74 S 572 29627 54 S 573 74 S 573 27 S 15 54740 27 S 25 3604 54741 7640 27 S 26 3624 7641 27 S 27 3625 5605 7642 27 S 28 5625 7643 27 S 29 38510 7644 27 S 30 6340 7645 27 S 31 5340 6341 7646 27 S 32 5341 63 S 440 7647 27 S 33 53 S 440 63 RA 441 7648 53 RA 441 63 RS 441 7649 28 L 42 53 RS 441 63 S 441	

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II *(Fortsetzung)*	28 L 45 53 S 441 6348 82 HS 137 28 L 46 5348 6349 82 HS 147 28 P 42 5349 6350 82 S 115 28 P 45 5350 6351 82 S 136 28 R 45 5351 6352 82 S 137 28 S 4 XFD 5352 6353 82 S 140 28 SA 41 5353 82 S 141 28 S 42 HM 6641 82 S 142 28 SA 42 82 S 146 28 S 45 7054 82 S 147 28 S 46 7059 28 SA 46 93438 CY 7 C 225 7121 93448 7122 93452 7123 93453 7124 7125 7126 7226 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Programmierbare Lesespeicher, nicht löschbar (sogenannte PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 8 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften oder nicht mehr als 28 Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 24 S 81 3628 74 LS 478 82707 24 SA 81 74 S 2708 82708 24 S 86 5380 74 S 454 82 HS 185 5381 74 S 455 82 LS 180 27 S 180 5388 74 S 478 82 LS 181 27 S 181 5389 74 S 479 82 S 180 27 S 185 53 S 840 82 S 181 27 S 35 53 S 841 7608 82 S 182 7680 82 S 183 28 L 85 54 LS 478 7681 82 S 184 28 L 86 54 S 2708 7684 82 S 185 28 P 85 54 S 454 7685 82 S 2708 28 R 35 54 S 455 7686 28 R 85 54 S 478 7687 87 S 180 28 S 2708 54 S 479 7688 87 S 181 28 S 85 7689 87 S 184 28 S 86 6380 87 S 185 28 SA 86 6381 77 S 180 87 S 186 28 S 8 XMFE 6388 77 S 181 87 S 187 6389 77 S 184 29623 63 S 840 77 S 185 93450 29630 63 S 841 77 S 186 93451 29631 77 S 187 93460 29632 7050 93461 29633 7055 TBPS 81 M 93465 29634 7060 93466 29635 93 L 450 29636 7127 93 L 451 29637 7128 29650 7129 9460 29651 7130 29652 7131 CY 7 C 235 29653 7132 CY 7 C 281 7232 CY 7 C 282	

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II *(Fortsetzung)*	oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Programmierbare UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm und einem Quarzfenster auf der Oberseite. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AMI 702 ADC 82140 PP oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	4
ex 85.21 D II	Programmierbare UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMs) mit programmierbaren Ein- und Ausgangsstellen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 2 K × 8 bit, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 52 mm und einem Quarzfenster auf der Oberseite. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: D 8755 A, TMP 8755 AC oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung mit einer Speicherkapazität von 4 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: X 2804 A, X 2404, X 24 C 04 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AM 2817 A X 24 C 16 X 2816 A 52 B 13 52 B 13 H oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II	Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: X 2864 A MBM 28 C 64 MBM 28 C 65 MCM 2864 52 B 33 52 B 33 H oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 128 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: X 28128 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder diese Kombinationen als Bestandteil enthält: 28256 28 C 256 48 C 256 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in TTL-Technik hergestellt (sogenannte TTL-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 1 Kbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 45 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 93422 93425 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 1 K × 4 bit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 70 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 23 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AM 2149 PD 2149 SY 2149 H TMS 2149 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 85.21 D II	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), mit einer Speicherkapazität von 4 K × 1 bit, einer Zugriffszeit von nicht mehr als 70 Nanosekunden und einem Versorgungsstrom im Bereitschaftszustand von weniger als 1 mA, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 26 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 6147 MCM 61 L 47 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), mit einer Speicherkapazität von 2 K × 8 bit und einer Leistung im Bereitschaftszustand von nicht mehr als 0,005 Milliwatt bei 25 °C, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: TC 5516 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 85.21 D II	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 8 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen-Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 4008 8104 8108 4118 8112 PD 421 8114 8185 4801 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 256 × 4 bit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 25 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 9122 – 25 91 L 22 – 25 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Statische Schreib-Lesespeicher, mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: TC 5564 MB 8464 TC 5565 C MB 81 C 71 MB 81 C 78 MCM 6164 HM 6264 P HM 6264 LFP HM 6264 LP oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS(einschließlich (H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, statisch), in Form einer monolitischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 72 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: TMM 2089 oder eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Monolithische integrierte Schaltung, bestehend aus einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch), mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, bitweise gekoppelt mit einem elektrisch löschbaren Lesespeicher (sogenannter E²PROM), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: X 2002 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II	Monolithische integrierte Schaltung, bestehend aus einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch), mit einer Speicherkapazität von 4 Kbit, bitweise gekoppelt mit einem elektrisch löschbaren Lesespeicher (sogenannter E^2PROM), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: X 2004 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in ECL-Technik hergestellt (sogenannte ECL-RAM(s), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 4 Kbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 50 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 32 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 10470 10474 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Vom Anwender teilweise programmierbare Schaltmatrix (sogenannter Programmable Logic Array/PLA), in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit schmelzbaren Verbindungsstücken, einer programmierbaren UND-Anordnung, einer festen ODER-Anordnung, mit nicht mehr als 20 Eingangsstellen und nicht mehr als 10 Ausgangsstellen, auch mit Registern in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 19 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine der Kombinationen als Bestandteil enthält: 10 H 8 — 16 A 4 — 18 L 4 10 L 8 — 16 C 1 16 H 2 — 20 C 1 12 H 6 — 16 L 2 — 20 L 2 12 L 6 — 16 L 6 — 20 L 10 12 L 10 — 16 L 8 — 20 R 4 16 R 4 — 20 X 4 14 H 4 — 16 R 6 — 20 X 14 L 4 — 16 R 8 — 20 X 10 14 L 8 — 16 X 4 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf eine Schaltmatrix der vorstehenden Beschreibung bezieht.	5
ex 85.21 D II	Vom Anwender programmierbare, nicht löschbare Schaltmatrix (sogenannter Field Programmable Logic-Array/FPLA), in TTL-Schottky-Technik hergestellt, mit nicht mehr als 48 UND-Funktionen und nicht mehr als 8 ODER-Funktionen sowie nicht mehr als 16 Eingangsstellen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:	

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II *(Fortsetzung)*	FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 82 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf eine Schaltmatrix der vorstehenden Beschreibung bezieht.	5
ex 85.21 D II	Programmierte Schaltmatrix (Gate Array) in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung mit nicht weniger als 8 000 Zwei-Eingangs-NAND-Funktionen, in einem Gehäuse mit 179 oder mehr Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 39 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MB 66000 VH oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf eine Schaltmatrix der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Video-Schaltmatrix (sogenannter Video Gate Array) zur Kontrolle von Graphik und Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und Abmessungen von nicht mehr als 15 × 52 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 38300 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf eine Video-Schaltmatrix der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Ein-Chip-Mikrocomputer in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer arithmetischen, logischen Einheit (Rechenwerk) mit einer Kapazität von 4 bit, einem Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 18 Kbit bis 65 Kbit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 512 bit bis 4 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 80 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 58 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CD 3200 bis 3299 TP 0310 bis 03299 HD 38800 TP 0450 bis 04599 HD 38820 TMC 0270 bis 0279 TP 0480 bis 04899 HD 44796 TMC 0500 bis 0599 TP 0500 bis 05999 HD 44800 TMC 0980 bis 0989 HD 44801 TMC 1500 bis 1599 HD 44820 TMC 1980 bis 1999 HD 44840 HD 44860 HD 614042 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Zentraleinheiten (sogenannte Central Processing Units/CPU), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem 16 × 16 bit-Dienstspeicher, einem 16 × 20 bit-Dienstspeicher, einem 32 × 32 bit-Dienstspeicher, einem 8 × 8 bit-Dienstspeicher, einem 16-bit-Register, zwei 20-bit-Registern, einem 8-bit-Register, einem 12-bit-Register, einem 5-bit-Zähler und einem Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm.	

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil hat LSI-604041855 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Zentraleinheiten der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Kontrollbaustein zum Steuern der Zugangsfolge (sogenannter Local Area Network Controller/LAN-Controller), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 63 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: MCM 68590 AM 7990 COM 9026 HD 2840 8001 8003 82586 82588 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Kontrollbaustein zur Steuerung von Magnetplattenspeichern mit festen Platten (Hard Disc Controller/HDC), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 53 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: WD 1010 WD 2010 HD 5010 HDC 9224 PD 7261 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Arithmetische, logische Einheit (Rechenwerk) in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem 32-bit-Register, einem 24-bit-Register, einem 4-bit-Register, zwölf 1-bit-Registern, zwei 16 × 24 bit-Dienstspeichern, einem logischen Element zum Durchführen arithmetischer und logischer Operationen, einer Decodierlogik, einem logischen Element zur Fehlersuche und -beseitigung, einem 8-bit-Zähler und einem Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 64 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 23 × 82 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: ALU 0486 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Rechenwerke der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Logischer Kontrollbaustein, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem 7-bit-Register, drei Zeitzählern (Timer), einem Wähler (Multiplexer), Elementen zur Folgekontrolle, einer Decodierlogik, einem logischen Element zur Fehlersuche und -beseitigung und einem Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 64 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 23 × 82 mm.	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MIC 0482 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Taktgeber in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, für Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit/CPU), Hauptspeicher und Ein- und Ausgangsschnittstellen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: H 108982 (MCC) oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Taktgeber der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Baustein zur Folgekontrolle, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem 32-bit-Register, drei 16-bit-Registern, einem 16 × 16 bit-Dienstspeicher, einem 7 × 17 bit-Kellerspeicher (Last in first out/Lifo), einem Addierwerk, einer Decodierlogik, einer Prioritätslogik, einem logischen Element zur Fehlersuche und -beseitigung, einem 16-bit-Wähler (Mulitplexer), einem 8-bit-Zähler und einem Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 64 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 23 × 82 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: CSS 0484 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Kontrollbaustein zur Fehlersuche und -beseitigung (sogenannter Error Detection and Correction Circuit), in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 62 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 2960 74 F 630 74 F 631 DP 8400 74 LS 630 74 LS 631 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Kontrollbaustein zur Fehlersuche und -beseitigung von einzelnen Bit-Fehlern und zur Fehlersuche von doppelten Bit-Fehlern (sogenannter Error Detection and Correction Circuit), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm.	

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 8206 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Kontrollbaustein zur Fehlersuche und -beseitigung von Mehrfachfehlern im Magnetplattensystem (sogenannter Burst Error Processor/BEP) in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: Z 8065 AM 9520 AM 9521 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Kontrollbaustein in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, zur Steuerung dynamischer Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, dynamisch), mit Adressen-Multiplexer und Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 62 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: DP 8408 DP 8409 MB 1422 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Programmierbarer Schnittstellenbaustein (sogenannter Programmable Communication Interface/PCI), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält 8251 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 85.21 D II	Programmierbarer Schnittstellenbaustein für die Datenübertragung (sogenannte Enhanced Programmable Communication Interface/EPCI), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 2661 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II	Serienschnittstellenbaustein zur Datenstromcodierung oder -decodierung und damit zusammenhängenden Kontrollfunktionen für einen Steuerbaustein zum Steuern der Zugangsfolge (sogenannter Local Area Network), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AM 7991 8002 8023 82501 COM 9032 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Schnittstellenbaustein für die parallel-serielle oder seriell-parallele Umsetzung digitaler Signale in Fernsprechapparaten (sogenannter Station Interface Digital/STID), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: WCC 295 G oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Programmierbarer Intervall-Zeitgeber (sogenannter Programmable Interval Timer/PIT), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 8253, 8254 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Intervall-Zeitgeber der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Baustein zur Frequenzdecodierung (sogenannter Demodulator/Tone Decoder) in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 14 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 21 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: XR 2211 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	C-MOS-Uhrenschaltungen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 54 mm, zum Herstellen von Schaltzeituhren oder Armaturbrettuhren und dergleichen für Kraftfahrzeuge oder Krafträder (a).	

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: HI 2060 HI 2065 MSM 5537 T 3605 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Uhrenschaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	C-MOS-Uhrenschaltungen, die von einer einzigen 1,5-Volt-Versorgungseinheit gespeist werden, mit LCD-Treiber, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 56 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 21 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: TC 8219 AF oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Uhrenschaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Verstärker in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 10 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 2 × 4 × 4 mm, zum Herstellen von Waren der Tarifstelle 90.19 B I (a). Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: V 35 C 05 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Verstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Vierkanal-Bus-Sendeempfangsbaustein (sogenannter Quad Bus Transceiver) in advanced low power Schottky-Technik hergestellt, mit D-Typ-Registern auf dem Chip und internen 4 bit-Generator/Prüfer auf ungerade Parität, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 28 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AM 2907 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Vierkanal-Bus-Sendeempfangsbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Treiberbaustein (sogenannter Four-Line-Driver) in advanced low power Schottky-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 7 × 20 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AM 26 LS 29 AM 26 LS 31 SN 75172 SN 75174	

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II *(Fortsetzung)*	oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Treiberbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Sendeempfangsbaustein zur synchronen/asynchronen Datenübertragung (sogenannter Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter/USART) in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MSM 82 C 51 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Sendeempfangsbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 85.21 D II	8-bit-Mikroprozessor mit interner Architektur von 16 bit in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, bestehend aus einer Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit/CPU), einem Zeitgenerator, zwei unabhängigen Kanälen zum Direktzugriffspeicher, einem programmierbaren Unterbrecher (sogenannter Interrupt Controller), drei programmierbaren 16-bit-Taktgebern, einem programmierbaren Speicher und äußerer Chipauswahllogik, einem programmierbaren Bereitschaftszustandsgenerator mit Bus-Kontrolleinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 80188 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 85.21 D II	16-bit-Mikroprozessor in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 82 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AM 29116 SBP 9989 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	16-bit-Mikroprozessor in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, bestehend aus einer Zentraleinheit [sogenannte Central Processing Unit (CPU)], einem Zeitgenerator, zwei unabhängigen Kanälen zum Direktzugriffspeicher, einem programmierbaren Unterbrecher (sogenannter Interrupt Controller), drei programmierbaren 16-bit-Taktgebern, einem programmierbaren Speicher und äußerer Chipauswahllogik, einem programmierbaren Bereitschaftszustandsgenerator mit Bus-Kontrolleinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 80186 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II	16-bit-Mikroprozessor, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit/CPU), einem Baustein für die Organisation des Speichers (sogenannte Memory Management Unit/MMU) und einem internen Betriebssystem für reale und virtuelle Adressierung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 80286 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	10
ex 85.21 D II	32-bit-Mikroprozessor in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 114 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 36 × 36 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MC 68020 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	32-bit-Mikroprozessor in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer hybriden integrierten Schaltung, bestehend aus einer Substratebene mit zwei Chips, die die Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit/CPU) und die Speichereinheit bilden, mit nicht mehr als 60 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 55 mm. Der Baustein trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 57-00000, 57-19400 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Gleitkomma-Coprozessor (sogenannter Floating Point Coprozessor) in C-MOS-Technik hergestellt, mit acht 80-bit-Registern und einem 32-bit-Bus, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 80 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 28 × 28 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Beispiel enthält: MC 68881 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Coprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Numerischer Prozessor (sogenannter Numeric Processor Extension/NPX) in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit nicht mehr als 14 Registern, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 52 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:	

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II *(Fortsetzung)*	8087 TX 32081 W 80287 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf numerische Prozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Datentrennbaustein für flexible Magnetplatten (sogenannter Floppy Disc Data Separator/FDDS), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 27 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: FDC 9216 FDC 9216-B WD 9216-00 WD 92 C 32 FDC 9229 T FDC 9229 BT oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf eine Datentrennschaltung der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Phonem-Sprachsynthetisator in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-Phoneme Speech Synthesizer), mit einem Versorgungsstrom von weniger als 10 mA, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CM 54104 CM 54166 N2L CD 54123 N2L CM 54145 N2L CD 54121 N2L CD 54147 N2L CM 54146 N2L CD 54122 N2L SC 01 SSI 263 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Phonem-Sprachsynthetisatoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Dreifacher Video-Digital-Analog-Umsetzer (sogenannter Video Digital-Analog-Converter/VDAC) mit einer Kapazität je Kanal von nicht mehr als 8 bit, mit einer Signalumsetzungszeit von nicht mehr als 25 Nanosekunden, in Form einer monolithischen oder hybriden integrierten Schaltung, auch mit drei Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte RAMs) mit einer Speicherkapazität von jeweils nicht mehr als 2 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 61 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 54 × 62 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: VDAC 444 TD TDC 1334 RGB DAC 4 T HDAC 34010 RGB DAC 8 E HDAC 34020 RGB DAC 8 T oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Video-Digital-Analog-Umsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Differentialverstärker, steuerbar für Signale von 0 bis 400 MHz oder mehr, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 11 mm.	

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 0078-10 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Differentialverstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in bipolarer Technik hergestellt (sogenannte bipolare RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung mit einer Speicherkapazität von 64 × 9 bit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 40 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 82 S 09 MBM 93419 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Treiberbaustein für dynamische 8-bit-Speicher (sogenannter Octal Dynamic Memory Driver) in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AM 2965 AM 2966 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Treiberbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Bus-Schnittstellenbaustein in bipolarer Technik hergestellt, mit 9-bit- oder 10-bit-Registern, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 34 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AM 29821 AM 29843 AM 29823 AM 29844 AM 29824 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Mehrbus-Puffer-Schnittstellenbaustein (sogenannter Multiple Bus Puffer) in low power Schottky-Technik hergestellt, für die Fehlersuch- und Beseitigungseinheit, das Datenbus-System und den dynamischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, dynamisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AM 2961 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II	Zustands- und Schiebekontrollbaustein (sogenannte Status and Shift Control Unit) in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 42 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 57 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AM 2904 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Zustands- und Schiebekontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Verstärker, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, mit den Abmessungen von nicht mehr als 3 × 3 mm, zum Herstellen von Waren der Tarifstelle 90.19 B I (a)	0
ex 85.21 D II	Text-Coprozessor in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: C 82 730 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Text-Coprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Ein-Chip-Mikrocomputer in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer arithmetischen, logischen Einheit (Rechenwerk) mit einer Kapazität von 8 bit, einem programmierbaren UV-löschbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Speicherkapazität von 32 Kbit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 1 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 50 mm sowie einem Quarzfenster. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 8751, 7742 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Ein-Chip-Mikrocomputer in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer arithmetischen, logischen Einheit (Rechenwerk) mit einer Kapazität von 32 bit, einem Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 24 Kbit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit in einem Gehäuse mit nicht weniger als 84 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht weniger als 30 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MB 8764 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Teilnehmerleitung-Sprach-Signal-Baustein (sogenannter Subscriber Line Audio Processing Circuit/SLAC) mit 2 Digitalsignalprozessoren, einem Analog-Digital- und einem Digital-Analog-Umsetzer, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.	

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AM 7901 AM 7905 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Warenbeschreibung bezieht.	7
ex 85.21 D II	Nicht flüchtiger Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-RAM, statisch) mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit und interner Energiequelle, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 19 × 36 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: MK 48 Z 02 (B), DS 1220 Y oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf nicht flüchtige Speicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 85.21 D II	Kontrollbaustein für die Datenein- und -ausgabe und Zeitfolge, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit einem statistischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 128 × 8 bit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 6532 CO 10750 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Analog-Digitaler-Steuerbaustein zur Kontrolle der Schwingungen des Schrittmotors während des Positionierens, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: STEDA oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Analog-Digitaler-Steuerbaustein für bürstenlose Motoren, zur Erhaltung einer konstanten Geschwindigkeit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 6 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MGA 3015 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II	Analog-Digitaler-Steuerbaustein für bürstenlose Motoren, zur Erhaltung einer konstanten Geschwindigkeit, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: UC 1634, UC 1633, UC 3633, UC 3634 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Baustein für die Organisation des Speichers (sogenannte Memory Management Unit/MMU), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit einer Speicheradressierbarkeit bis zu 16 Megabyte, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 64 Anschlußstiften oder 68 Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 82 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 68451, TX 32082 W oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Baustein für die Organisation des Speichers (sogenannte Memory Management Unit/MMU), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr 132 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als als 36 × 36 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MC 68851 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Baustein zur asynchronen Bus-Kontrolle und zur Umwandlung der lokalen Bus-Leitungen in Multiplex-Leitungen in advanced low power Schottky-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 37 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 68452 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Kontrollbaustein für Kathodenstrahlröhren (sogenannter Cathode Ray Tube Controller/CRTC) in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 62 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:	

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II *(Fortsetzung)*	AM 8052 D 8275 H P 8275 H oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 85.21 D II	Baustein zur Anzeigenkontrolle und zur Erzeugung von Zeichen (sogenannter Display Controller und Character Generator/DCCG) in C-MOS-Technik hergestellt, für Flüssigkristall-Punktmatrixanzeigen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 60 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 20 × 26 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: HD 61830 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Video-Digital-Analog-Umsetzer (sogenannter Video-Digital-Analog-Converter/VDAC), mit einer Signalumsetzungszeit von nicht mehr als 10 Nanosekunden, in Form einer hybriden integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 20 × 35 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Video-Digital-Analog-Umsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Interpolations-Baustein (sogenannter Interpolation Pulse Generator) zur Steuerung geometrischer Funktionen, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: KM 3701 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Interpolations-Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), mit einer Speicherkapazität von 32 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: TC 5532 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II	Baustein zur Steuerung von Servovorrichtungen in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: KM 3702 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Baustein zur Erzeugung variabler Wellenformen in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 21 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: XR 2206 XR 8038 oder — eine Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Video-Verstärkerbaustein in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 17 mm, zum Herstellen von tragbaren Farbfernsehkameras (a). Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 702 703 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Verstärkerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Baustein zur Verstärkung entweder der Lese- oder der Schreibsignale von flexiblen Magnetplatten, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 29 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: XR 2247 XR 3470 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Baustein zur Blenden- und Farbtemperaturausgleichsteuerung in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 17 mm, zum Herstellen von tragbaren Farbfernsehkameras (a). Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 704	

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II *(Fortsetzung)*	oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Taktgeber in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten digitalen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm, zum Herstellen von tragbaren Farbfernsehkameras (a). Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 705 706 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Taktgeber der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in bipolarer Technik hergestellt (sogenannte bipolare RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer Substratebene mit 1 oder 2 Chips mit einer Speicherkapazität von jeweils 1 Kbit in einem Gehäuse mit nicht mehr als 23 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 13 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 770639, 770823, 5120360, 7379769 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in bipolarer Technik hergestellt (sogenannte bipolare RAMs, statisch) in Form von monolithischen integrierten Schaltungen, bestehend aus 2 übereinander angeordneten Substratebenen mit 1 oder 2 Chips mit einer Speicherkapazität von jeweils 1 Kbit und einer Gesamtspeicherkapazität von nicht mehr als 4 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 23 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 13 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 770965 4599497 7379442 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Programmierbarer Signalsynthetisator (sogenannter Digital Signal Synthesizer) in C-MOS-Technik hergestellt, mit 32 Frequenzgeneratoren zur Erzeugung von jeweils 8 Tönen und einem gleichzeitigen Output von bis zu 160 Tönen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MEG oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Signalsynthetisatoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II	Baustein zur Regeneration pulscode-modulierter Signale, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 21 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: XR C 240 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Kontrollbaustein in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, zur Steuerung dynamischer Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, dynamisch), mit Adressen-Multiplexer und Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften oder 52 Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 62 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: C 8208 THCT 4502 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Sendeempfangsbaustein mit zwei Kanälen zur asynchronen Datenübertragung (sogenannter Dual Universal Asynchronous Receiver Transmitter/DUART), in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 52 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: SCN 2681, MC 2681 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Sendeempfangsbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	C-MOS-Uhren/Datum-Schaltungen mit Quarzschwinger, unabhängigen Zeitzählregistern und einem Taktgeber, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 7 × 20 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: MM 58174 A, 58274 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Uhrenschaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	C-MOS-Uhrenschaltung mit Tonausgabe, auch mit Stundenzähler, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht:	

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II *(Fortsetzung)*	SVM 5530 7910 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Uhrenschaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Sendeempfangsbaustein für asynchrone Daten (sogenanntes Asynchronous Communication Element) in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: INS 8250 NS 16450 WD 8250 NS 16 C 450 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Sendeempfangsbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, dynamisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 64 K × 4 bit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 parallelen Anschlußstiften (Dual-in-Line) und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 34 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: TMS 4464, PD 41254, PD 41464, TMM 41464 M5M 4464, HM 50464, MB 81464 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf dynamische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	10
ex 85.21 D II	Dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 150 Nanosekunden, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften in Zig-Zag-in-Line-Anordnung und den Abmessungen von nicht mehr als 12 × 22 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: PD 41256 V MB 81256 P HM 50256 ZP oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	10
ex 85.21 D II	Manchester-Codier- und Decodierbaustein (sogenannter Manchester-Encoder-Decoder/MED) zur kontinuierlichen Datenübertragung, mit Wiederholungsmodus, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einer Ausgangsspannung von 4,5 Volt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: HD 6409	

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II *(Fortsetzung)*	oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Codier- und Decodierbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Programmierbare UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 512 Kbit, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 20 × 42 mm und einem Quarzfenster auf der Oberseite. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine diese Kombinationen als Bestandteil enthält: AM 27512, MBM 27 C 512 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	TTL-Logikbaustein in bipolarer Technik hergestellt, mit nicht mehr als sechs logischen Funktionen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 34 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: SH 767 369 SH 998 088 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Logikbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Kontrollbaustein für Zentraleinheiten (sogenannter CPU-Controller), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: FE 2000 L1A0392 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Kontrollbaustein für flexible Magnetplatten (sogenannter Floppy Disc Controller/FDC), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 62 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: MB 89311, L 1 A 0519, G 70360-33 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 85.21 D II	Monolithische integrierte Schaltung zur Pulscode-Modulation (sogenannte Pulse Code Modulation/PCM) in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit Codier-, Decodier- und Filterfunktionen, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 23 mm.	

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II *(Fortsetzung)*	Das Gerät trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 2916 2917 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 85.21 D II	Baustein mit 6 Kanälen zur Verstärkung und Umwandlung der Lesesignale und zur Umwandlung der Schreibsignale für Magnetplattenspeicher mit festen Platten (sogenannter Read/Write Data Processor Circuit), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 19 × 38 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine diese Kombinationen als Bestandteil enthält: SSI 540, SSI 541 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf 6-Kanal-Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	8-Kanal-Steuerbausteine zur Erhaltung einer konstanten elektromagnetischen Andruckskraft, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Dioden und 8-bit-Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 28 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: UCN 5801 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	4-Kanal-Steuerbausteine zur Erhaltung einer konstanten elektromagnetischen Andruckskraft, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Dioden und 4-bit-Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 7 × 22 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: UCN 5813 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Baustein mit 6 Kanälen zur Erzeugung von Schreib- und Lesesignalen für Magnetplattenspeicher mit festen Magnetplatten, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 13 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: SSI 117 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf 6-Kanal-Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II	Programmierbare Lesespeicher, nicht löschbar (sogenannte PROMS), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 27 PS 191 A 7 C 245 7 C 292 MB 7133 MB 7137 MB 7151 29683 7 C 291 HM 6616 MB 7134 MB 7138 MB 7152 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Verstärker, steuerbar für Signale von 0 bis 60 KHz und mit einem Reststrom von nicht mehr als 0,3 Mikroampere, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 6 × 13 × 26 mm, zur Verwendung in Fernsprechanlagen (a). Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: ISO 100 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Verstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Ein-Chip-Mikrocomputer, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer arithmetischen, logischen Einheit (Rechenwerk) mit einer Kapazität von 4 bit, einem Lesespeicher (sogenannter ROM), mit einer Speicherkapazität von 2 K × 8 bit, einem Doppel-Ton-Multifrequenz (DTMF)-Generator, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 1 Kbit, auch mit einem weiteren Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 512 bit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 42 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: T 6978, TCM 8301, TCM 8302 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 16 × 4 bit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 35 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 21 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CY7C189 CY7C190 CY74S189 CY54S189 CY27S03 CY27S07 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), mit einer Speicherkapazität von 256 × 4 bit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 60 Nanosekunden, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 12 × 29 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CY7C122 CY 93422/93L422 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen) mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit, zur Verwendung beim Herstellen von mit Mikrowellen arbeitenden Objekt- oder Personenidentifizierungssystemen (a)	0
ex 85.21 D II	Dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, dynamisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer Substratebene mit nicht weniger als 2 und nicht mehr als 8 Chips mit einer Speicherkapazität von jeweils 128, 192 oder 256 Kbit und einer Gesamtspeicherkapazität von nicht weniger als 256 Kbit und nicht mehr als 2 Megabit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 57 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 6025841 6031587 6870392 7379172 6025843 6031591 6870393 7379174 6025856 6870395 7379176 6025858 7379181 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf dynamische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff und dualer Ein-/Ausgangsstelle in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, dynamisch), mit Datenregister und serieller Leseausgangskontrolle, mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: PD 41264, MB 81461 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Bus-Schnittstellenbaustein zur Kontrolle der Übertragungsleitungen in C-MOS-Technik hergestellt, bestehend aus einem numerischen Bus, zwei unabhängigen Empfängern und einem Sender mit FIFO (First In/First Out)-Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 20 × 52 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: HS 3282	

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II *(Fortsetzung)*	oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Monolithische integrierte Schaltung in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, zum Erzeugen von graphischen Symbolen auf einem Kathodenstrahl-Bildschirm in Vektor-Schreibweise, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 28 × 61 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: FCD 28 042 277, 96 114 898, 96 114 899, 96 149 135 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: HM 62256, PD 43256 C, TC 55257 P oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in ECL-Technik hergestellt (sogenannte ECL-RAMs), mit einer Speicherkapazität von 256 × 4 bit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 8 Nanosekunden, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 32 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 10422, 10422 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in ECL-Technik hergestellt (sogenannte ECL-RAMs), mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 15 Nanosekunden, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 27 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 10480 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Oktal-Treiberbaustein (sogenannter Eight-Line-Driver) in TTL-Schottky-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 14 × 14 mm.	

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 5170, NE 5170, UC 5170 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Treiberbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Oktal-Empfangsbaustein (sogenannter Eight-Line-Receiver) in TTL-Schottky-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 14 × 14 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 5180 5181 8510 NE 5180 NE 5181 8511 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Empfangsbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Schnittstellenbaustein zur Datenstromsynchronisierung von festen Magnetplatten, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 35 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: DP 8462 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Datentrennbaustein für feste Magnetplatten (sogenannter Hard Disc Data Separator/HDDS), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 37 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: DP 8465 WD 10 C 20 DP 8460-2 HDC 9226 DP 8460-3 DP 8460-4 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Datentrennbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Hybride integrierte Schaltung zum Steuern von Elektromagneten, bestehend aus vier Darlington-Transistoren (ein Darlington = 2 Transistoren in Kaskadenschaltung), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 10 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 12 × 27 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: TH3L10, TH3L20, PU 4419	

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II *(Fortsetzung)*	oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Schnittstellenbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, für den peripheren Festmagnetplattenspeicher und der Zentraleinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 28 × 53 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: OMTI 508 AIC 500 OMTI 509 AIC 16000 WD 11 C 00 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Baustein zur Folgekontrolle der Daten zwischen Festmagnetplattenspeicher und Speicherkontrolleinheit, in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 28 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AIC 010 AIC 100 OMTI 505 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Serienschnittstellenbaustein zur Datenstromcodierung und -decodierung für Festmagnetplattenspeicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 37 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: OMTI 507 OMTI 5027 AIC-250 AIC-270 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Schreib-Lese-Baustein mit 4 Kanälen zur Kontrolle der Magnetköpfe in Festmagnetplattenspeichern, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 12 × 19 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: SSI 510 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schreib-Lese-Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II	Kontrollbaustein in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, zur Steuerung statischer Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch), mit Adressen-Multiplexer und Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 28 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: OMTI 506 AIC 300 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Programmierte Schaltmatrix (Gate Array), nicht vom Anwender programmierbar, in C-MOS-Technik mit metallischen Gates hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Betriebsspannung von 12 V, mit nicht weniger als 637 Zwei-Eingangs-Funktionen und einem durch Elektronenstrahl hergestellten Digitalcode in der Matrix, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 29 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: FB 215 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf eine Schaltmatrix der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 85.21 D II	Monolithische integrierte Schaltung zur Pulscode-Modulation (sogenannte Puls Code Modulation/PCM) in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, bestehend aus einer Tastspeicherschaltung (sogenannter Sample and Hold Circuit), Digital-Analog-Umsetzer, Grenzwertangleicher, Register für sukzessive Approximation, logischer Funktion für eine Schnittstelle zu einer PCM-Linie zur gleichzeitigen Datenübermittlung in beiden Richtungen (Full Duplex), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 28 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 2911A-1 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 85.21 D II	Sendeempfangsfilter zur Pulscode-Modulation (sogenannte Pulse Code Modulation/PCM) in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, für einen PCM-Leitungsanschluß, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 21 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: D 2912 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Sendeempfangsfilter der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 85.21 D II	Dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff, in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, dynamisch), mit einer Speicherkapazität von 256 Kbits, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 34 mm.	

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: P 51 C 256 P 51 C 259 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf dynamische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Monolithische integrierte Schaltung zum Umwandeln analoger Signale in digitale Signale, mit Verstärkern, Digital-Analog- und Analog-Digital-Umsetzern, mit einer Versorgungsspannung von 12 V ± 10 % und einer digitalen Serienschnittstelle mit asynchronem Sendeempfänger, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 18 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AD 75002 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Kontrollbaustein für Kathodenstrahlröhren (sogenannter Cathode Ray Tube Controller/CRTC), in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 55 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: SCB 2675 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Kontrollbaustein für monochrome Anzeigen (sogenannter Monochrome Display Controller/MDC), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 01-01.00 551 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Programmierbare Lesespeicher, nicht löschbar (sogenannte PROMs), mit einer Speicherkapazität von 32 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 63S3281, AM 27S43, MB 7141, MB 7142 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II	Kontrollbaustein für Videoanzeigen (sogenannter Advanced Video Display Controller/AVDC) in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 55 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: SCN 2674 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 85.21 D II	Kontrollbaustein zum Steuern magnetischer Drucktypen, in TTL-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und nicht mehr als 7 × 20 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 801379-002 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Teilnehmerleitungs-Einheit (sogenannter Crosspoint Switch) mit nicht weniger als 4 und nicht mehr als 12 Schaltern, mit einer Betriebsspannung von 150 V oder mehr, in Form einer hybriden integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 94 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 41 × 92 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 904 719 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Einheiten der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	8 × 8 bit Rechenbaustein zum Multiplizieren und Addieren (sogenannter Multiplier Accumulator/MAC) in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 62 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: ADSP-1008A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Rechenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Analog-Digital-Umsetzer zur Berechnung des Durchschnittswerts variabler Wellenformen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 14 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 18 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AD536A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Analog-Digital-Umsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II	12-bit-Analog-Digital-Umsetzer mit Referenzspannung und Taktgeber, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 36 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AD574A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Analog-Digital-Umsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Vierfacher Digital-Analog-Umsetzer mit einer Kapazität je Kanal von 12 bit, in Form einer hybriden integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 21 × 41 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AD 390 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Digital-Analog-Umsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Prozessor zur Puffer-Steuerung (sogenannter Buffer Management Control Processor) in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: WD1015 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Prozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Prozessor zur Puffer-Steuerung (sogenannter Buffer Management Control Processor) in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 84 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 31 × 31 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: WD11C00-22 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Prozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 D II	Thermoelementverstärker mit eingebautem Alarmsystem zur Kontrolle von Instrumenten innerhalb eines Temperaturbereichs von nicht weniger als 0 und nicht mehr als 50 °C, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 14 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 20 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AD594 AD595 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Thermoelementverstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 85.21 D II	Temperaturfühler in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 3 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 4 × 6 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AD590 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Temperaturfühler der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85.21 E	Kathodenstrahlröhren-Ablenkeinheiten für Frequenzen von nicht weniger als 31 250 und nicht mehr als 64 000 Hz, mit einem 4-Pol-Magneten	0
ex 85.23 B	Isolierter Wickeldraht, weder lackiert noch verniert, aus Aluminium mit einer Reinheit von 99,5 Gewichtshundertteilen oder mehr, mit einer Gesamtdicke von nicht weniger als 0,15 und nicht mehr als 0,16 mm	0
ex 90.02 B	Lichtwellenumkehrleiter aus optischen Fasern	0
ex 90.02 B	Regelbares Objektiv mit einer Brennweite von nicht weniger als 115 und nicht mehr als 140 mm, bestehend aus 4 bis 8 Linsen aus Glas oder Methacrylat, die einen Durchmesser von nicht weniger als 120 und nicht mehr als 130 mm aufweisen und jeweils auf mindestens einer Seite mit Magnesiumfluorid beschichtet sind, zum Einbau in Videoprojektoren (a)	0
ex 90.02 B	Optisches Element, bestehend aus zwei Lagen starrer, optischer Fasern zwischen zwei Kunststoffplatten, mit den Abmessungen von nicht mehr als 5 × 20 × 276 mm, zum Herstellen von Photokopierapparaten (a)	0
ex 90.10 A	Optische Einheit für Photokopierapparate, bestehend aus zwei Lagen starrer, optischer Fasern zwischen zwei Kunststoffplatten, einer röhrenförmigen Lampe und einem Metallreflektor, auf einem metallischen Halter mit den Abmessungen von nicht mehr als 40 × 100 × 335 mm	0
ex 90.10 A	Einheit für Photokopierapparate, bestehend aus einer Halogenlampe und einem Metallreflektor, jedoch ohne optisches Element, auf einem metallischen Halter mit den Abmessungen – ohne Kabel und Anschlußstücke – von nicht mehr als 53 × 112 × 290 mm	0
ex 90.19 B II	Tragbare Lesevorrichtung für hochgradig Sehbehinderte, bei der eine von Hand zu führende Fiberoptik-Kamera Dokumente abtastet und ein vergrößertes Bild auf einen Bildschirm überträgt, und ihre Teile	3
ex 92.12 A	Starre Oxid-Magnetplatten, vorgeschmiert, mit einer Koerzitivkraft von 800 Oersted/Oe, einem Außendurchmesser von 95 mm, einem Innendurchmesser von 25 mm und einer Dicke von 1,27 mm	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.